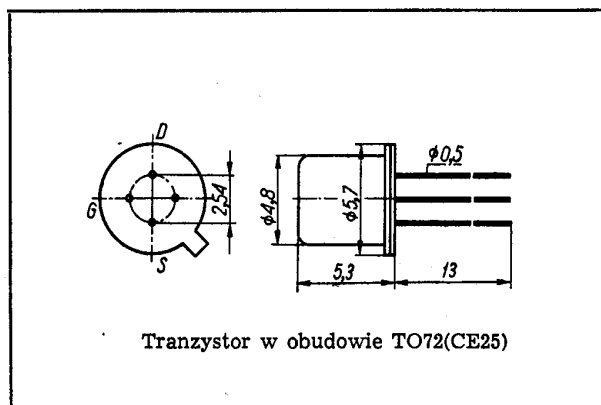


Tranzystor krzemowy polowy MOS epiplanarny z kanałem typu p wzbogacającym, z izolowaną bramką. Jest przeznaczony do stosowania w układach przełączających małej mocy oraz w układach o dużej impedancji wejściowej.



DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie ujęcie-źródło	$-U_{DS}$	25	V
Napięcie bramka-źródło	U_{GS}	± 20	V
Prąd ujęcia	I_D	500	mA
Moc strat	P	250	mW
Temperatura kanału	t_{ch}	423 (150)	K °C

SWW 1156-21

Zakres temperatury otoczenia

t_{amb}	233...373 (-40...+100)	K °C
-----------	---------------------------	---------

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		<u>min.</u>	<u>maks.</u>	
Prąd upływu bramki przy $U_{GS} = 20$ V, $U_{DS} = 0$	I_{GSS}	—	100	pA
Napięcie progowe bramki przy $I_D = -10$ μ A, $U_{DG} = 0$	$-U_{GS(TO)}$	4	14	V
Prąd upływu ujęcia przy $U_{DS} = -15$ V, $U_{GS} = 0$	I_{DSS}	—	5	nA
przy $U_{DS} = -15$ V, $U_{GS} = 0$, $t_{amb} = 373$ K (100°C)	I_{DSS}	—	2	μ A

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		<u>min.</u>	<u>maks.</u>	
Konduktancja przejściowa przy $I_D = 5$ mA, $U_{DG} = 0$	g_m	1	—	mS
Rezystancja kanału przy $I_D = 1$ mA, $U_{GS} = -20$ V	$r_{DS(on)}$	—	700	Ω
przy $U_{DS} = -15$ V	$r_{DS(off)}$	300	—	M Ω

PRODUCENT i DYSTRYBUTOR



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
PÓLPRZEWODNIKÓW

Zakład Doświadczalny Półprzewodników przy ITE
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa
telefon: 431431 do 39, teleks: 813219